

产品概览

NTMFD4901NF: 双 N 沟道，功率 MOSFET，带集成肖特基，30V

欲看完整文档，请参阅数据表。

双 N 沟道，功率 MOSFET，带集成 30 V，高压侧 18 A / 低压侧 30 A，双 N 沟道，SO8FL

特性

- Co-Packaged Power Stage Solution to Minimize Board Space
- Low Side MOSFET with Integrated Schottky
- Minimized Parasitic Inductances
- Optimized Devices to Reduce Power Losses
- RoHS Compliant

应用

- DC-DC Converters
- System Voltage Rails
- Point of Load

器件电气规格

产品	Pricing (\$/Unit)	Compliance	Status	Channel Polarity	Configuration	$V_{DS(s)}$ Min (V)	V_{GS} Max (V)	$V_{GS(th)}$ Max (V)	I_D Max (A)	P_D Max (W)	$R_{DS(on)}$ Max @ $V_{GS} = 2.5$ V (mΩ)	$R_{DS(on)}$ Max @ $V_{GS} = 4.5$ V (mΩ)	$R_{DS(on)}$ Max @ $V_{GS} = 10$ V (mΩ)	Q_3 Typ @ $V_{GS} = 4.5$ V (nC)	Q_3 Typ @ $V_{GS} = 10$ V (nC)	C_{iss} Typ (pF)	Package Type
NTMFD4901NFT1G	0.9113	Pb-free Halide free	Active	N-Channel	Dual	30	20	2.2	18.2	1.9	-	Q1: 10, Q2: 3.5	Q1: 6.5, Q2: 2.35	63	9.7	Q1: 1150, Q2: 2950	SO-8FL Dual / DFN-8
NTMFD4901NFT3G	0.9113	Pb-free Halide free	Active	N-Channel	Dual	30	20	2.2	18.2	1.9	-	Q1: 10, Q2: 3.5	Q1: 6.5, Q2: 2.35	63	9.7	Q1: 1150, Q2: 2950	SO-8FL Dual / DFN-8

欲了解更多信息，请联系您当地的销售支援 www.onsemi.cn。

创建于：8/7/2020